

2SC4257 - NPN三重拡散プレーナ形シリコントランジスタ 高電圧増幅、高電圧スイッチング用

- 特長
- ・高耐圧である。
 - ・ c_{ob} が小さい。
 - ・ASOが広い。
 - ・高信頼性である(HVPプロセス採用)。

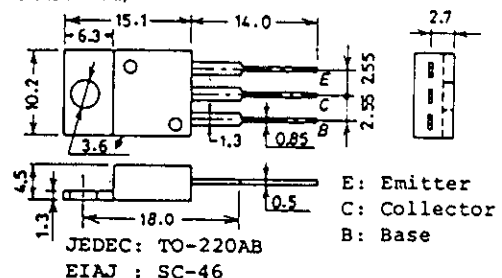
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / $T_a = 25^\circ\text{C}$

			unit
コレクタ-ベース電圧	V_{CB0}	1500	V
コレクタ-エミッタ電圧	V_{CEO}	1200	V
エミッタ-ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	30	mA
ピークコレクタ電流	i_{cp}	100	mA
コレクタ損失	P_C	1.75	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

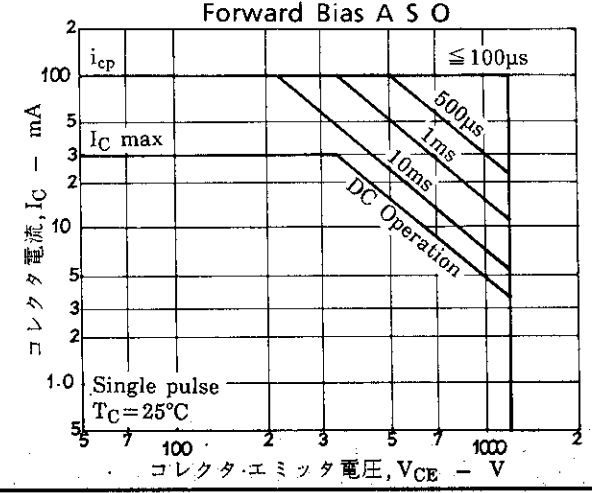
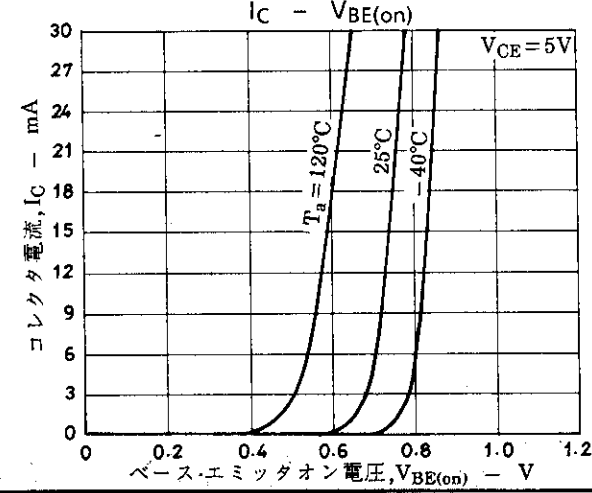
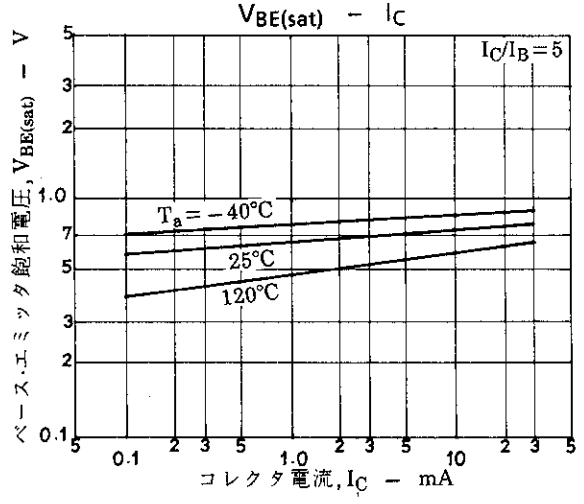
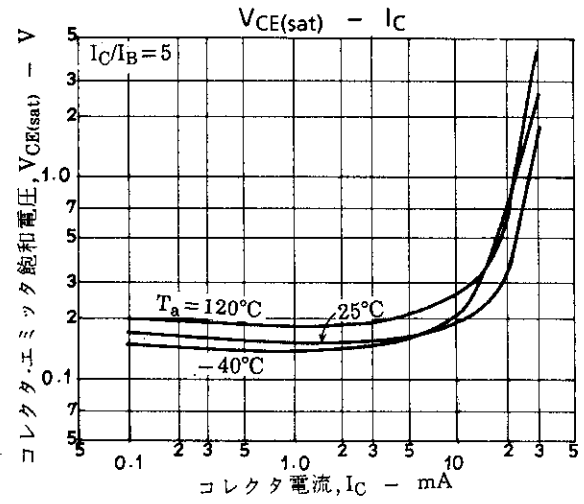
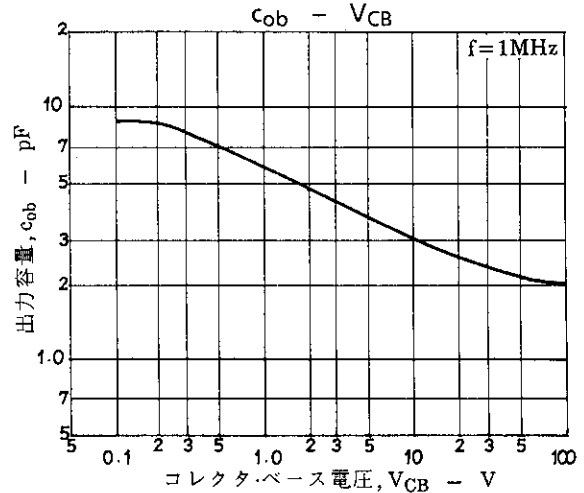
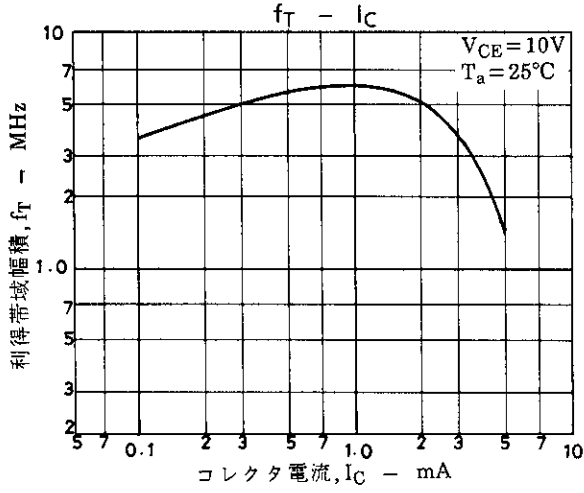
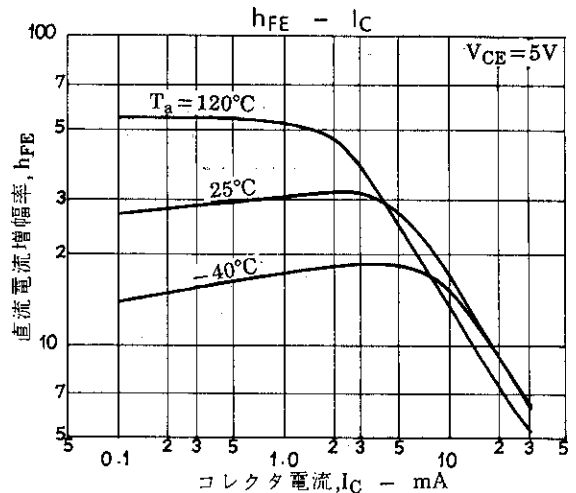
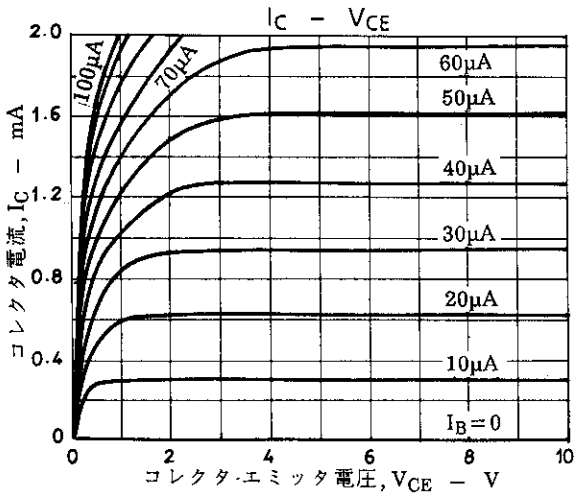
電気的特性 Electrical Characteristics / $T_a = 25^\circ\text{C}$

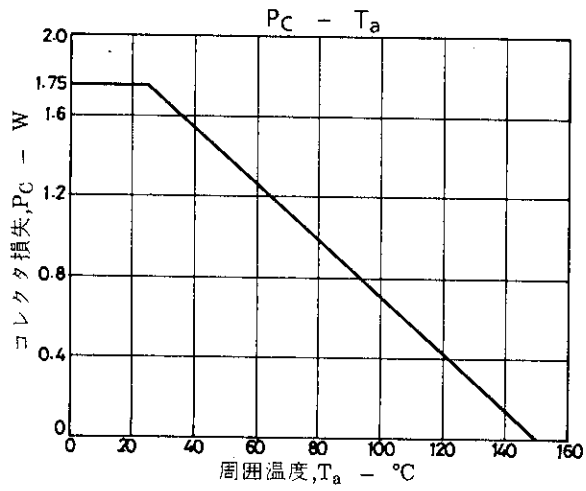
			min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 1200\text{V}, I_E = 0$			1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 4\text{V}, I_C = 0$			1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 1.5\text{mA}$	10		60	
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 1.5\text{mA}$		6		MHz
コレクタ-エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 3\text{mA}, I_B = 0.6\text{mA}$			5	V
ベース-エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 3\text{mA}, I_B = 0.6\text{mA}$			2	V
コレクタ-ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = 100\mu\text{A}, I_E = 0$	1500			V
コレクタ-エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 1\text{mA}, R_{BE} = \infty$	1200			V
エミッタ-ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 100\mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
出力容量	c_{ob}	$V_{CB} = 100\text{V}, f = 1\text{MHz}$		2.0		pF

外形図 2010A
(unit: mm)



※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。





この資料の応用回路および回路定数は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。

またこの資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行なうものではありません。

The application circuit diagrams and circuit constants herein are included as an example and provide no guarantee for designing equipment to be mass-produced. The information herein is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SANYO for its use; nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.